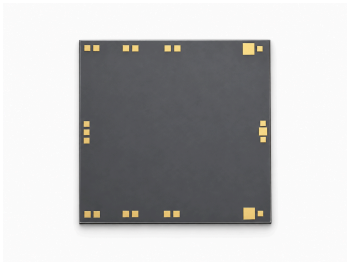


11500–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 44 dBm (Minimum) / 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 19.5 dB (typisch); PAE: 28 % (Minimum) / 30 % (typisch).
Chipabmessungen: 3.52 × 3.55 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 μs; D = 10%

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	f	11500	-	18000	11500–18000	MHz
Sättigungsausgangsleistung	Psat	44	44.5	-	-	dBm
Leistungsverstärkung	Gp	19	19.5	-	-	dB
Welligkeit der Leistungsverstärkung	ΔGp	-	-	±0.5	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	28	30	-	-	%
Kleinsignalverstärkung	S21	28	29	31	-	dB
Welligkeit der Kleinsignalverstärkung	ΔS21	-	-	±1.5	-	dB
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	1.8	2	-	-

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	Vd	-	28	-	-	V
Gatespannung	Vg	-	-2.4	-	-	V
Drain-Ruhestrom	Id	-	-	-	1.85 (Vd = +28 V; Einstellbar; die Quelle kennzeichnet den Wert weder als Minimum noch als typischen Wert oder Maximum.)	A

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	28	dBm
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C
Maximale Kanaltemperatur	Top	-	-	200	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	3.52 × 3.55 × 0.1	mm

Aktueller Publikationsstand · 1.4 · 2026-10-26. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.3.

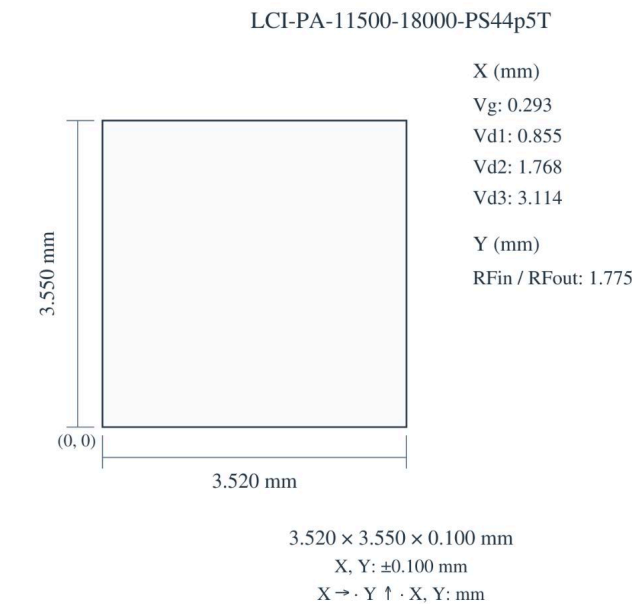
Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Integrierte DC-Sperrkondensatoren: RFin / RFout. DC-Pfad nach Masse: RFin / RFout → GND. Intern verbundene Gate-Pads: Vg ↔ Vg. Separate Charakterisierung: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 μs; D = 10%. Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

Quellenbasierte Umrissdarstellung mit ausdrücklich bemaßten Koordinaten in mm. Keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Mechanische Maßzeichnung



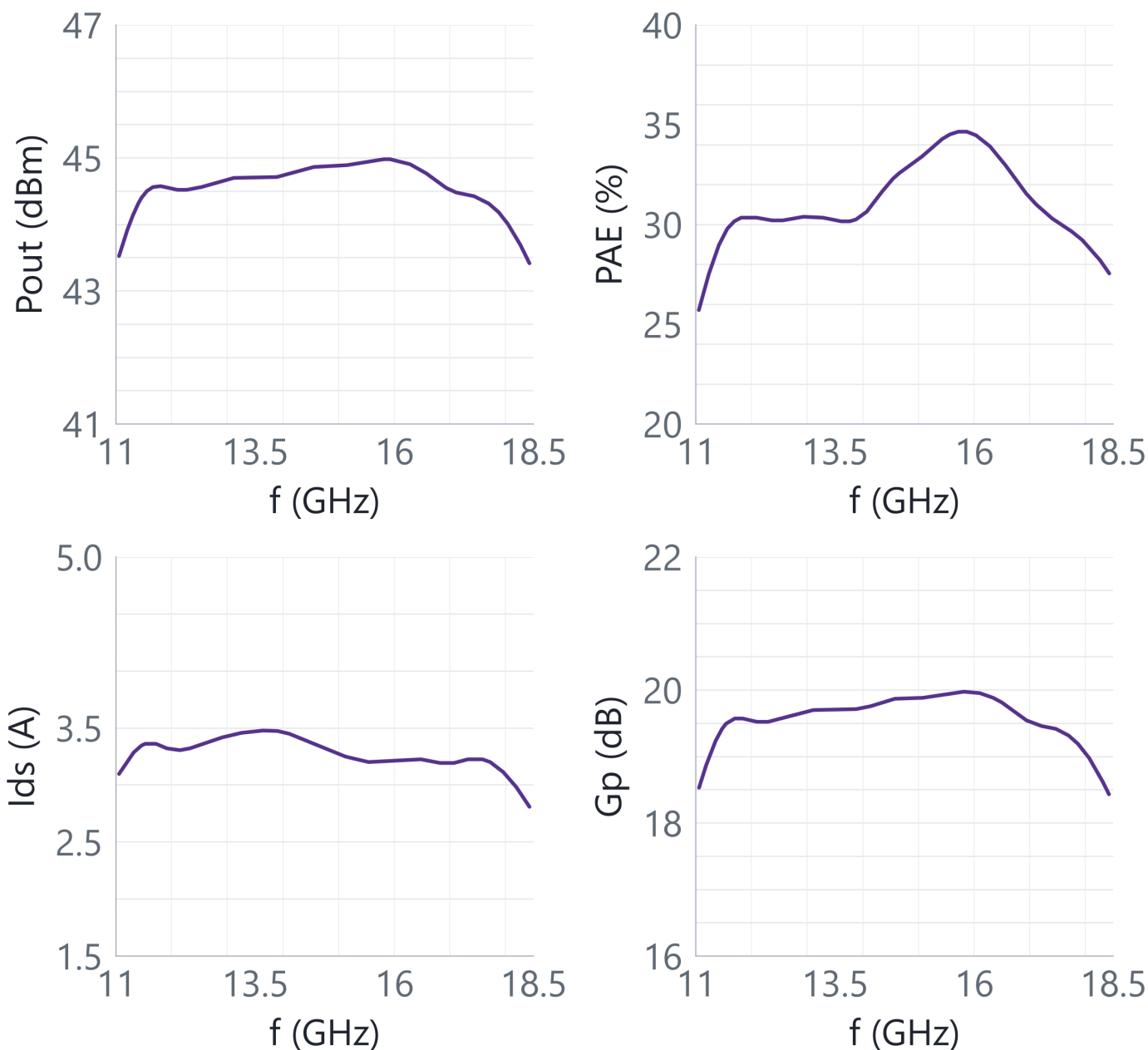
Alle Maße in mm [in].

Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Gepulst — Sättigungsausgangsleistung; Dynamischer Drainstrom; Leistungsaddierte Effizienz; Leistungsverstärkung.

Angabe auf der Quellseite: $T_A = +25^\circ\text{C}$; $V_d = +28\text{V}$; $V_g = -2.4\text{V}$; $P_{in} = 25\text{dBm}$. Pulsbreite = 100 μs ; Tastgrad = 10%. Aus der Originalabbildung digitalisiert; die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.



[Quelle](#)

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.